

H10 半導体装置；他に分類されない電氣的 固体装置 [2 0 2 3 . 0 1]

H10B 電子記憶装置 [2 0 2 3 . 0 1]

注

このサブクラスでは、セクションCの注(3)の周期表中に示されたI～VII族のシステムが用いられる。

サブクラス内の索引

揮発性記憶装置

SRAM..... 10/00

DRAM..... 12/00

不揮発性記憶装置

ROM; PROM; EPROM..... 20/00

フローティングゲートを含むEEPROM..... 41/00

電荷トラッピングゲート絶縁体を含むEEPROM... 43/00

強誘電性のメモリトランジスタを含むFeRAM.... 51/00

強誘電性のメモリキャパシタを含むFeRAM..... 53/00

MRAM..... 61/00

抵抗変化メモリ..... 63/00

他のEPROM..... 69/00

複数の装置の組立体..... 80/00

他の電子記憶装置

このサブクラスの他のグループに分類されない主題事項99/00

揮発性記憶装置 [2 0 2 3 . 0 1]

10/00 スタティックランダムアクセスメモリ [SRAM] 装置 [2 0 2 3 . 0 1]

10/10 ・バイポーラ構成部品からなるSRAM装置 [2 0 2 3 . 0 1]

12/00 ダイナミックランダムアクセスメモリ [DRAM] 装置 [2 0 2 3 . 0 1]

12/10 ・バイポーラ構成部品からなるDRAM装置 [2 0 2 3 . 0 1]

不揮発性記憶装置 [2 0 2 3 . 0 1]

20/00 読み出し専用メモリ [ROM] 装置 [2 0 2 3 . 0 1]

20/10 ・バイポーラ構成部品からなるROM装置 [2 0 2 3 . 0 1]

20/20 ・電界効果構成部品からなる書き込み可能なROM [PROM] 装置 (H 1 0 B 2 0 / 1 0 が優先) [2 0 2 3 . 0 1]

20/25 ・一回のみ書き込み可能なROM [OTPROM] 装置, 例. 電氣的に溶断可能なリンクを用いるもの [2 0 2 3 . 0 1]

41/00 フローティングゲートを含む電氣的消去・書き込み可能なROM [EEPROM] 装置 [2 0 2 3 . 0 1]

41/10 ・上から見たレイアウトに特徴のあるもの

[2 0 2 3 . 0 1]

41/20 ・三次元配置, 例. 異なる高さに配置されたセル, に特徴のあるもの [2 0 2 3 . 0 1]

41/23 ・異なる高さのソースとドレインを有するもの, 例. 傾斜チャネルを有するもの [2 0 2 3 . 0 1]

41/27 ・垂直部分を含むチャネル, 例. U字型チャネル [2 0 2 3 . 0 1]

41/30 ・メモリコア領域に特徴のあるもの [2 0 2 3 . 0 1]

41/35 ・セル選択トランジスタを有するもの, 例. NAND [2 0 2 3 . 0 1]

41/40 ・周辺回路領域に特徴のあるもの [2 0 2 3 . 0 1]

41/41 ・メモリ領域にセル選択トランジスタを有するもの, 例. NAND [2 0 2 3 . 0 1]

41/42 ・周辺セルおよびメモリセルの同時製造 [2 0 2 3 . 0 1]

41/43 ・周辺トランジスタを一種類のみ含むもの [2 0 2 3 . 0 1]

41/44 ・コントロールゲート層を周辺トランジスタの一部としても用いるもの [2 0 2 3 . 0 1]

41/46 ・ゲート間誘電体層を周辺トランジスタの一部としても用いるもの [2 0 2 3 . 0 1]

41/47 ・フローティングゲート層を周辺トランジスタの一部としても用いるもの [2 0 2 3 . 0 1]

41/48 ・トンネル誘電体層を周辺トランジスタの一部としても用いるもの [2 0 2 3 . 0 1]

41/49 ・異なる種類の周辺トランジスタを含むもの [2 0 2 3 . 0 1]

41/50 ・コアと周辺回路領域との間の境界領域に特徴のあるもの [2 0 2 3 . 0 1]

41/60 ・コントロールゲートがドープ領域であるもの, 例. 単層ポリメモリセル [2 0 2 3 . 0 1]

41/70 ・フローティングゲートが複数の構成部品で共有される電極であるもの [2 0 2 3 . 0 1]

43/00 電荷トラッピングゲート絶縁体を含むEEPROM装置 [2 0 2 3 . 0 1]

43/10 ・上から見たレイアウトに特徴のあるもの [2 0 2 3 . 0 1]

43/20 ・三次元配置, 例. 異なる高さに配置されたセル, に特徴のあるもの [2 0 2 3 . 0 1]

43/23 ・異なる高さのソースとドレインを有するもの, 例. 傾斜チャネルを有するもの

H 1 0 B

- [2 0 2 3 . 0 1]
- 43/27 ・ ・ ・ 垂直部分を含むチャネル，例．U字型チャネル [2 0 2 3 . 0 1]
- 43/30 ・ メモリコア領域に特徴のあるもの [2 0 2 3 . 0 1]
- 43/35 ・ ・ セル選択トランジスタを有するもの，例．NAND [2 0 2 3 . 0 1]
- 43/40 ・ 周辺回路領域に特徴のあるもの [2 0 2 3 . 0 1]
- 43/50 ・ コアと周辺回路領域との間の境界領域に特徴のあるもの [2 0 2 3 . 0 1]
- 51/00 強誘電性のメモリトランジスタを含む強誘電体メモリ [F e R A M] 装置 [2 0 2 3 . 0 1]
- 51/10 ・ 上から見たレイアウトに特徴のあるもの [2 0 2 3 . 0 1]
- 51/20 ・ 三次元配置，例．異なる高さに配置されたセル，に特徴のあるもの [2 0 2 3 . 0 1]
- 51/30 ・ メモリコア領域に特徴のあるもの [2 0 2 3 . 0 1]
- 51/40 ・ 周辺回路領域に特徴のあるもの [2 0 2 3 . 0 1]
- 51/50 ・ コアと周辺回路領域との間の境界領域に特徴のあるもの [2 0 2 3 . 0 1]
- 53/00 強誘電性のメモリキャパシタを含む強誘電体メモリ [F e R A M] 装置 [2 0 2 3 . 0 1]
- 53/10 ・ 上から見たレイアウトに特徴のあるもの [2 0 2 3 . 0 1]
- 53/20 ・ 三次元配置，例．異なる高さに配置されたセル，に特徴のあるもの [2 0 2 3 . 0 1]
- 53/30 ・ メモリコア領域に特徴のあるもの [2 0 2 3 . 0 1]
- 53/40 ・ 周辺回路領域に特徴のあるもの [2 0 2 3 . 0 1]
- 53/50 ・ コアと周辺回路領域との間の境界領域に特徴のあるもの [2 0 2 3 . 0 1]
- 61/00 磁気メモリ装置，例．磁気抵抗RAM [M R A M] 装置 [2 0 2 3 . 0 1]
- 63/00 抵抗変化メモリ装置，例．抵抗RAM [R e R A M] 装置 [2 0 2 3 . 0 1]
- 63/10 ・ 相変化RAM [P C R A M , P R A M] 装置 [2 0 2 3 . 0 1]
- 69/00 グループH 1 0 B 4 1 / 0 0 ~ H 1 0 B 6 3 / 0 0 に包含されない，消去可能でプログラム可能なROM [E P R O M] 装置，例．紫外線による消去可能でプログラム可能なROM [U V E P R O M] 装置 [2 0 2 3 . 0 1]
- 80/00 このサブクラスに包含される，少なくとも

1つの記憶装置を備える，複数の装置の組立体 [2 0 2 3 . 0 1]

99/00 このサブクラスの他のグループに分類されない主題事項 [2 0 2 3 . 0 1]